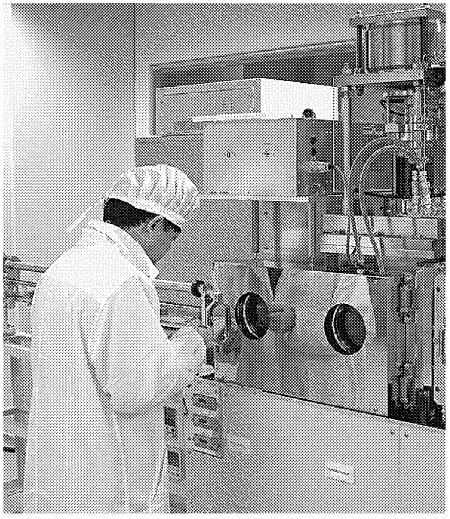


東京都墨田区にある東京工業大学の大岡山キャンパス。ここに二〇〇四年四月に発足したのが、「量子ナノエレクトロニクス研究センター」だ。現在の大規模集積回路（LSI）の限界を超える次世代LSIなどの開発を進める。

新型LSI分野超え協力



電子素子の上にレーザー光源とテラヘルツ波発振器などの素子を作製する

《研究抛点概要》

▽所在地	東京都目黒区大岡山 2-12-1
▽センター長	浅田雅洋教授
▽予算規模	約3億円(2008年度)
▽研究者数	12人(協力教員含む)
▽設立年月	2004年4月

の装置の中でシリコンの電子素子の上に、インジウム・リンなどの化合物半導体を使ってレーザー光源やテラヘルツ波発振器を作り込む作業が始まった。

共同作業は異例だが、研究室ごとに独創的な研究成果が生まれている。小田俊理教授と内田建准教授の研究室では新構造のトランジスタを考案した。田中・オフを切り替えるスイッチの電極に、機械的に上下するナノ電気機械システム（NEMS）という仕組みを活用。これまでのシリコン基板上に酸化膜層と金属層を順番に積んで作る素子に比べて、高速処理が実現できる。

膜を重ねる構造では電流がスイッチ側に漏れるがN辺機器の開発や新規の用途

授は「機械式スイッチは動きが遅いと思われがちだが、百メートル（ナノ十億分の一）以下寸法にすれば電気式の百倍以上になる」と話す。現在はコンピューター・シミュレーションで設計を進め、実際に動作できるデータを得た。このアイデアはハワイ・ホノルルで開催中のシリコン・ナノワードレクトロニクス・ワーキングショップで十五日に発表された。一年以内に実物を作りた。動作を確認する考え方だ。

西山准教授は米コーンリング社（ニューヨーク州）で緑色レーザーの開発を手がけた。電子デバイスが専門の内田准教授は今年四月に東芝から移ったばかりだ。

優秀な人材と自由な研究の雰囲気、産業化的意識から予想もできない全く新しい素子や機器が誕生することが期待される。

ただ大学の本部がセンターワークを実現している。そこで研究に特別に用意した予算は無い。「主要メンバー全員が個々に大型プロジェクトを獲得し研究費を

(黒川卓)